(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許出願公告番号

特公平6-90954

(24) (44)公告日 平成8年(1994)11月14日

(51) Int C1.*

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H 0 5 B 33/28 33/10

発明の数1(全 4 頁)

(21)出顧番号

特顯昭60-182294

(22)出願日

昭和60年(1985) 8月20日

(65)公開番号

特開昭62-43098

(43)公開日

昭和62年(1987) 2月25日

(71)出題人 999999999

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 滝沢 英明

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 長谷川 正

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 佐藤 精威

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 大菅 義之 (外1名)

審査官 槙原 進

(58)参考文献 特別 昭60-249294 (JP, A)

特公 昭43-22010 (JP, B1)

(54)【発明の名称】 エレクトロルミネツセントデイスプレイ用透明電極の形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】ガラス基板上に透明薄膜層を形成して熱処 理する工程と.

該透明薄膜層上にこの透明薄膜層より大きなエッチング レートを有する第2屆目膜を形成する工程と,

該第2層目膜上にストライプ状のレジストパターンを形 成してサイドエッチングによって上記透明薄膜層と第2 層目膜で形成されるテーパ状の電極を構成する工程と、 該第2層目膜を容易に溶解するが透明薄膜層を侵蝕しな い液に浸漉して2層目膜を除去する工程とよりなること を特徴とするエレクトロルミネッセントディスプレイ用 透明電極の形成方法。

【請求項2】前記2層目膜としてアルミニウム膜を選択 してなることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の エレクトロルミネッセントディスプレイ用透明電極の形

成方法。

【請求項3】 前記液としてリン酸液を選択してなること を特徴とする特許請求の範囲第1項記載のエレクトロル ミネッセントディスプレイ用透明電極の形成方法。

2

【発明の詳細な説明】

(発明の概要)

本発明はエレクトロルミネッセント(以下ELと記す)デ ィスプレイ用の透明電極の形成方法に関するもので、ス トライプ状に形成される透明電極にテーパを付加するた めに透明電極膜形成後に透明電極のエッチャントより大 きなエッチングレートを有する膜を形成し、レジストパ 「ターンを該膜上に形成してサイドエッチングによってテ ーパ状電極を形成した後に上記膜を溶解する液に浸漬 し、上記レジストパターンを含む膜を除去するようにし てテーパデット透明電極を形成するようにしたものであ

BEST AVAILABLE COPY

特公平6-90954

(2)

る。

[産業上の利用分野]

本発明はELディスプレイ用の透明電極の形成方法に係り、特にテーパ透明電極を形成するために電極用透明膜上に形成した膜を除去して電極形成工程時間を短縮化したELディスプレイ用透明電極の形成方法に関する。

(従来の技術)

従来一般にELディスプレイはフラット化が出来るだけでなく、消費電力が少なくフリッカやジッタがなく。更にXーYマトリックスであるため画面のゆがみ等もCRT (陰極線管)に比べて少ない。その構成は第3図に示すようになされている。即ちガラス基板1上にストライプ状の透明電極2を形成する。この透明電極2は絶線層3の絶縁耐圧を増すためにテーバデット化させ、表面は平滑に仕上げなければならない。絶縁層3の上には硫化亜鉛(ZnS)を母材とし発光源とし動作するマンガン(Mn)等を添加した発光層4を形成し、更に該発光層上に絶縁層5を形成して該絶縁層5の上に上記ストライプ状の透明電極1と直行してマトリックス状に金層の背面電極6を形成し、該背面電極6と透明電極2間に交流電圧等を印加して黄橙色の光を発光するようになされ、発光色としては希土類のフッ化物を発光源として用いると種

々の色のものが得られることが知られている。このような構成のELディスプレイに於いてガラス基板1上にテー

パデット化した透明電極を得るための工程を第2図
(a)~(c)について説明する。第2図(a)に於いてガラス基板1上に先ず透明電極として酸化鍋(SnO₂)
又は酸化チタン(TiO₂)等の第1の透明薄膜層2aをスパッタして500℃前後の熱処理を行う。次に熱処理を行った第1の透明薄膜層2a上に第2の透明薄膜層2bを低湿反 30 応性Dcスパッタでスパッタリングした後にストライプ状のレジストパターン7をフォトリソ法で形成し、熱濃塩酸でエッチング8を行うと矢印で示すように第1及び第2の透明薄膜層の2a,2bの厚み方向パーティカルエッチング並びに面方向へのサイドエッチングが行われる。この際、第1の透明薄膜層2aは完全に熱処理で多結晶化しているのに対し、第2透明薄膜層2bはアモルファス状態であるためにエッチングレートが異なるため第2図

(b) に示すようにレジストパターンの真下にもより多くのサイドエッチングがなされ、テーパデットされた透明電極2が形成される。次にレジストパターン7を除去する。第2の透明薄膜層2b上に絶縁層を形成する際に300℃前後の温度が加えられるためにアモルファス状態の第2の透明薄膜層2bが熱反応を起こして絶縁層に影響を与え目的に合った膜が得にくいために第2図(c)に示すようにレジストパターンを除去した後に第2の透明薄膜層2bを更に熱処理するようになされていた。

[発明が解決しようとする問題点]

上記の従来構成によると第2の透明薄膜層2bを熱処理するための時間が通常1時間乃至2時間程度と長時間化す

るだけでなく,透明薄膜層2a,2bからテーパデット透明 電極を得るためにエッチング条件,膜抵抗,膜厚等の相 互の依存性要因を考慮しなければならない欠点があっ た。

[問題点を解決するための手段]

本発明は上記欠点に鑑みなされたもので、その目的とするところは第2の透明薄膜層の熱処理工程を省き熱処理工程時間の掛からない透明電極の形成方法を得るにあり、その手段はガラス基板上に透明薄膜層を形成して熱処理する工程と、該透明薄膜層上にこの透明薄膜層のエッチャントより大きなエッチングレートを有する第2層目膜を形成する工程と、該第2層目膜上にストライブ状のレジストパターンを形成してサイドエッチングによって上記透明薄膜層と第2層目膜で形成されるテーパ状の電極を構成する工程と、該第2層目膜を容易に溶解するが透明薄膜層を侵蝕しない液に浸漬して2層目膜を除去する工程とよりなることを特徴とするエレクトロルミネッセントディスプレイ用透明電極の形成方法によって達成される。

20 〔作用〕

本発明はEL案子の透明電極形成時に該電極をテーパデット化する場合に熱処理された透明薄膜層上に熱処理されないアモルファス状の薄膜層をスパッタリングするが、この薄膜層は透明である必要はなく、上記透明薄膜層により形成される電極のエッチャントに対し、より大きなエッチングレートを持つ薄膜層を選択し、上記電極の表面を侵蝕しない除去液によって上記薄膜層を溶解させることでレジストパターン除去後にも薄膜層を除去するようにしたものである。

0 [実施例]

以下、本発明の一実施例を第1図(a)~(c)につい て詳記する。第1図(a)においてガラス基板上に所定 の電極高さとなるように透明薄膜層2a(ITO)をスパッ タリングして、次の工程で透明薄膜層2aを500℃程度で 熱処理することで多結晶化した透明薄膜層28の上に例え ばアルミニウム膜等の上記透明薄膜のエッチャントであ る熱濃塩酸(40℃)よりエッチングレートの大きい第2 層目膜26′をスパッタリングして、更に次の工程でフォ トリソ法でレジストパターン7を上記第2層目膜2b′上 に形成し、エッチャントである熱濃塩酸によってエッチ ングを行うことでレジストパターンの形成されていない 部分から浸透した熱濃塩酸は矢印に示すようにアルミ膜 である第2層目膜2b′の厚み方向並びに面方向をサイド エッチングする。その結果、第1図(b)の如きθ=10 °~15°程度のテーパの付いた電極2a.2b′が得られ る。次に第1図(c)に示すようにレジストパターンプ を剥離後に更に透明薄膜層2aを侵さないリン酸に浸して 第2層目膜2b′のアルミ膜を除去して透明薄膜層2aだけ を残すと所定高さの透明電極2がテーパ化されて形成さ 50 hs.

BEST AVAILABLE COPY

特公平6-90954

(3)

上記実施例では第2層目膜2b′にアルミ膜を更に透明薄 膜層を侵さず第2層目膜2b′だけを溶解させるエッチャ ントにリン酸を用いたが必ずしも、これに限ることはな く例えば第2層は透明膜であってもよく,次の条件を満 足する第2層目膜並びにエッチャントを選択すればよ

- (1) 透明電極となる透明薄膜層2aのエッチャントに対 して、これより大きなエッチングレートを持つ第2層目 膜となるような材質を選択する。
- (2) 透明電極の表面を少しも侵食しないで第2層目膜 10 だけを完全に溶解するエッチャントを選択する。このよ うな膜とエッチャントであれば何でもよいことは明らか である。

(発明の効果)

本発明は上述の如く構成させ、かつそのプロセスを選択 したので従来のノーンアニールITOを2層目膜として再 びアニールする場合に比べてパターンニング後の熱処理 工程が省ける。本発明ではこの熱処理工程の代わりにエ ッチング工程が増加するが、従来の熱処理工程では真空 中で1時間~2時間の時間をかけて熱処理を行うのに対 20 8……エッチング. し、本発明のエッチング工程では通常の雰囲気中でエッ

チング液に没すだけで時間も10分程度で工程時間は大幅 に短縮される。又透明電極も2層膜でないので設計が簡 単で透明電極上に形成する絶縁膜に影響を与えることも ない透明電極を形成できる特徴を有する。

【図面の簡単な説明】

第1図(a)~(c)は本発明のELディスプレイ用透明 のELディスプレイ用透明電板の形成工程を示すEL案子の 側断面図、第3図は従来のELディスプレイ構成を示す斜 視図である。

1 ……ガラス基板,

2 ……透明電極,

2a……第1の透明薄膜層,

2b……第2の透明薄膜層。

2b' ……第2層目膜,

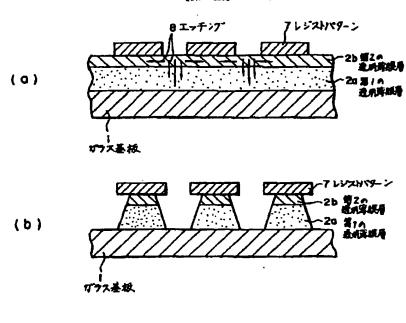
3,5……絶縁層.

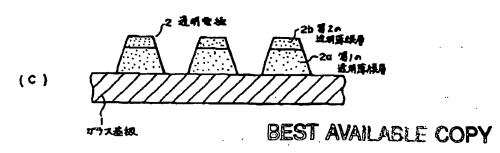
4 ……発光層,

6……背面電極,

7……レジストパターン,

【第2図】

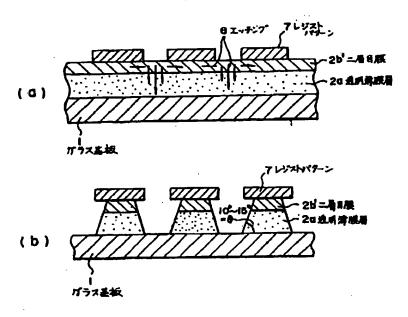


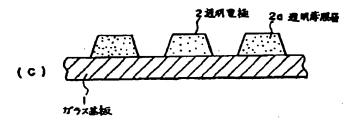


(4)

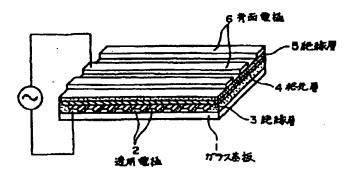
特公平6-90954

【第1図】





【第3図】



BEST AVAILABLE COPY